# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

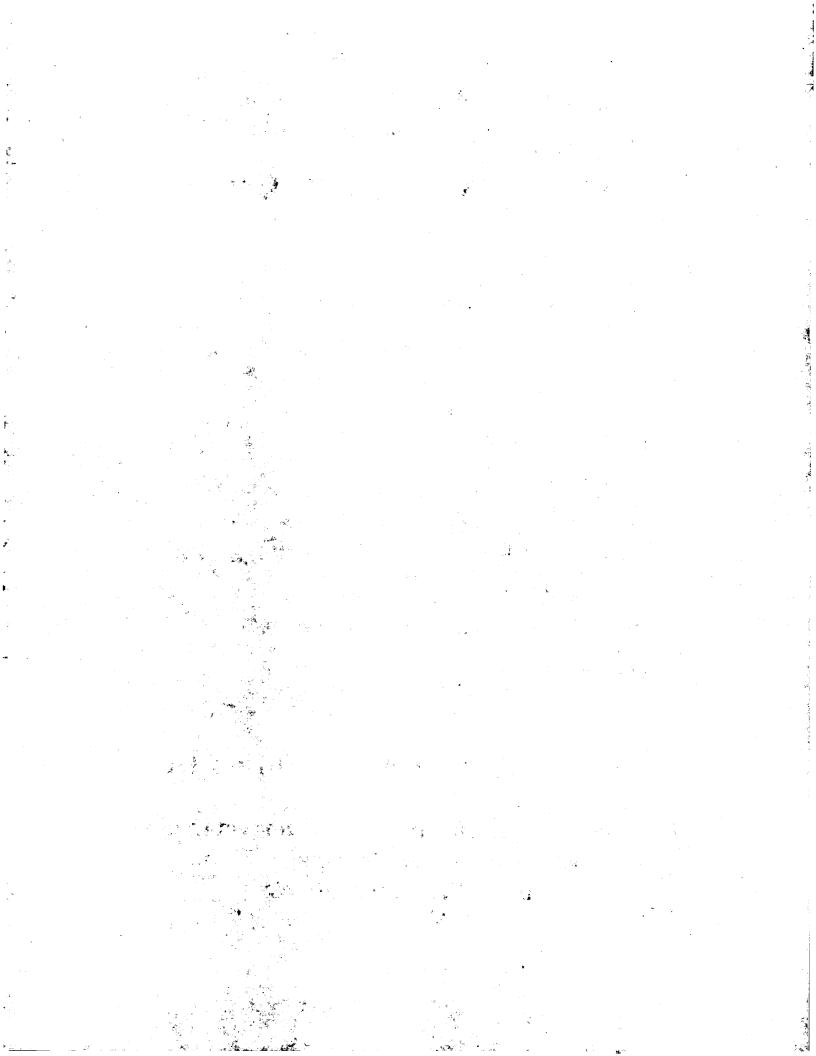
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



SZSSO-82 AqT which corresponds to

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

JPB 63-038697

(11) Publication number: 58083853 A

(43) Date of publication of application: 19.05.83

(51) Int. CI

G03F 1/00 G01B 11/00 H01L 21/30

(21) Application number: 56180978

(22) Date of filing: 13.11.81

(71) Applicant:

NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

(72) Inventor:

ONO KOICHI MATSUURA TOSHIO

#### (54) MASK SUBSTRATE FOR CHECK

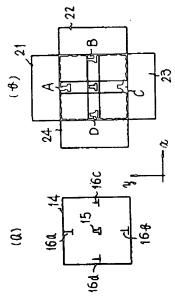
#### (57) Abstract:

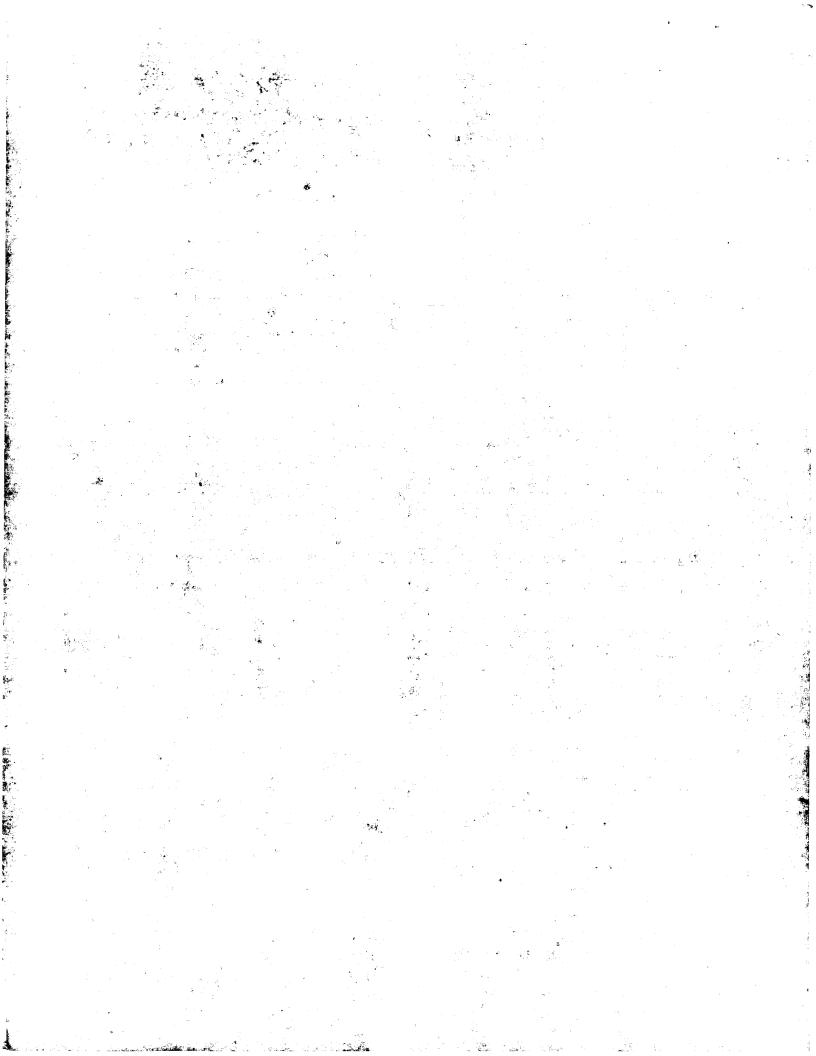
PURPOSE: To measure optical characteristics of a projecting optical system accurately, by providing one of plural marks on a reticle in the position through which the optical axis of the projecting optical system passes.

CONSTITUTION: A main scale pattern 15 of a reticle 14 is provided in the part through which the optical axis of a projecting lens, and vernier scale patterns 16aW16d are arranged in middle parts between upper, lower, left, and right edges. First, the image of the reticle 14 is printed to a wafer as shown in figure by a dotted line. Next, a wafer stage is moved in the (y) direction by the interval between the main scale and the vernier scale to print the image of the reticle 14, and a printed image 21 is obtained. In this case, a vernier A where the first printed image of the vernier scale pattern 16a and the next printed image of the main scale pattern 15 are superposed is formed. Similarly, verniers BWD are obtained. Since the main vernier is placed in the center of the printed image when verniers AWD are observed by a microscope or the like, quantities of deviation of cross stripes of verniers AWD are read on the basis of

this main vernier, and thus, optical characteritics of the projecting optical system are measured accurately.

# COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio





19日本国特许庁(JP)

⑩ 特許出願公告

黔 公 錣(B2) 四 特

昭 63 - 38697

@Int Cl.4

識別記号

庁内望理番号

昭和63年(1988)8月1日 ❷❷公告

1/00 G 03 F 21/30 H 01 L

GCA 301

W - 7204 - 2HM - 7376 - 5F

発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

投影光学系のデイストーション検査方法

願 昭56-180978 创特

够公 昭58-83853

願 昭56(1981)11月13日 ❷出

❷昭58(1983) 5 月 19日

野 700発明 者 大

廢 斂 男 東京都稲城市平尾372-1-45-203

の発 明 者 松 浦 埼玉県越谷市瓦督根2-17-18

日本光学工業株式会社 顣 人 砂出

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

正夫 弁理士 岡部 個代 理 人

外3名

寮 斉 官 良 和

1

井

2

## の特許節求の節囲

1 マスク基板に形成されたパターンを感光基板 に投影露光するための投影光学系のデイストーシ ヨンを検査する方法において、

ほぼ中央に第1マークを有し、該第1マークか 5 ら所定間隔だけ離れた複数の位置に第2マークを 有する基準マスクを、前記第1マークが前記投影 光学系の光軸とほぼ一致するように配置しる

所定の第1位置に前記感光基板を配置して前記 する第1工程と;

前記第1マークの投彫像と前記第2マークの投 彫像との設計上の間隔だけ前記第1マークと第2 マークとを結ぶ方向にずれた第2位置に前記感光 基板を移動させる工程と;

前配第1工程で露光された前記感光基板に前記 基準マスクのマーク僚を再度投影露光する第2工 程と;

該感光基板上に解光された前記第1マークの像 前記第2マークの位置におけるデイストーション △を求める工程とを含むことを特徴とするデイス トーション検査方法。

2 前記第1マークと第2マークの夫々は、互い 格子縞パターンとして形成されていることを特徴 とする特許額求の範囲第「項記録の方法。

3 前記第1マークと第2マークのいずれか一方

を構成する前記格子縞パターンの各格子に段階部 を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第2項 記載の方法。

4 前記第1マークと第2マークのいずれか一方 を構成する前記格子縞パターンの各格子にテーパ 部を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第2 項記載の方法。

5 前記第1マークの格子縞パターンのピツチと 前記第2マークの格子縞パターンのピツチとをわ 基準マスクのマーク像を前記感光基板に投影露光 10 ずかに異ならせてパーニアの関係に定めておくこ とを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の方

## 発明の詳細な説明

本発明は、IC投影露光装置などの投影光学系 15 の歪曲、倍率誤差等の光学特性、所謂デイストー ションを検査する方法に関し、特に露光装置の投 影光学系の光学特性を、マスク上のマークを感光 基板上に焼き付けて検査する方法関する。

従来のこの種の検査用マスク基板(以下、単に と前記第2マークの傲との位置ずれ昼を検出し、20 レテイクルという)について説明する。第1図a は従来レテイクルの図であり、レテイクル1上に は上下、左右の緑の中央部に、それぞれ、マーク 2, 3, 4, 5が配置されている。各マーク2~ 5は、第1図bに示すような格子縞パターンを有 に直交する方向に規則的に格子を配列した2つの 25 し、主尺としてのマーク2, 5と、副尺としての マーク3、 &とでパーニアを模成する。主尺と副 尺のパターンを、例えばウエハ上に返ね合わせて 焼き付けることによりパーニアが形成され、その

ずれ量を測定することによつて投影光学系の光学 特性が検査される。

この模様を第1図cを用いて説明する。尚、第 1図aにおいてレテイクル1上の上と下に配置さ れたパターン2, 3はy方向のずれ量、左と右に 5 配置されたパターン4,5はx方向のずれ量を測 定するものであり、今これらのパターン2と3, 4と5の間隔を例えば80mmとする。また、これら のレティクル 1上のパターン 2~5を1/10縮小投 **影レンズ系の光学特性を測定するものとする。** 

ウエハ載置台上のウエハに先ずパターン・チツ プ8を焼き付け、ここでウエハ載置台に備えられ た4/100μπ程度以下の精度で測長可能なレーザ 載置台(ステージ)を駆動し、ウエハをx方向、 y方向にそれぞれ8mm正確に移動させる。そして 再びそれぞれレテイクル1上のパターン2,3, 4, 5をウエハ上に焼き付けると、第1図cのよ ップフの副尺パターン4の副パーニアが重なつて パーニア8を形成し、チップ8の副尺パターン3 の副パーニアとチップ9の主尺パターン2の主パ ーニアが重なつてパーニア 10を形成する。この とき、もし投影レンズ系に歪曲、倍率誤差などが 25 全くない場合、各パーニア8,10の主パーニア と副パーニアのずれ量は共にゼロとなる。しか し、投影レンズ系に歪曲、倍率誤差などがある場 合は、パーニア8または10の格子稿(いわゆる 目盛) にずれを生じる。このずれ量を測定するこ 30 ±40mm離れた位置に副尺パターン16c, 16d とによって、投影レンズ系により作られる第1図 aのレテイクル上のパターン2~5のパーニアの 存在する位置(すなわちパターン2~5に対応す るウエハ上のレテイクル像の位置) における投影 レンズ系の歪量や倍率鹍差を測つている。

しかし、以上の従来のものにおいては、投影レ ンズ系の歪曲、倍率誤差などの相対量しかわから ないという欠点がある。このことを第2図を用い て説明する。第2図は、投影レンズ系の歪曲、倍 される領域11と、投影レンズ系による歪曲等に よつて変形したウエハ上の投影像の領域 12とを 表わし、更に本図において投影像の中心13は投 **影光学系の光軸に一致している。この図示例にお** 

いて領域 12の x 方向の右側が左側よりも大きく 変形しているが、従来の方法では左右の変形量の 違いを検出できず、x方向の長さが領域11のそ れよりも短かい(または長い)ことがわかるだけ である。すなわち、上記の従来のものにおいて は、例えば領域12のx方向左右側が共に内側に 変形している場合、レテイクル1上のパターン 4,5に対応した投影像中のパターンの距離1 は、本来の距離よりも短かくなつてしまう。この 影露光装置でウェハ上に焼き付けて、1/10縮小投 10 ため、第1図cで示したパーニア8で投影像のx 方向のずれ量を測つても、それは単に領域 12の x 方向が領域 1 1 のそれよりも短かいことがわか るだけである。さらに、領域12の左右側が例え ば右側が外側に、左側が内側に同程度に変形して 一干渉計測長器などの測定値に基づいて、ウエハ 15 いると、パーニア8の格子縞のずれは相殺され て、歪曲等がないものとして測定されてしまう。 従つて中心 13からの絶対的な歪み量は求めるこ とができない。

本発明はこの欠点を解決して、投影光学系の光 うにチップ8の主尺パターン5の主パーニアとチ 20 学特性(デイストーション)を正確に検査するた めの方法を得ることを目的とするものである。

> 以下、第3図以降の図面を用いて本発明の実施 例を説明する。

第3図aに図示の第1実施例では、レテイクル 14の中央部、すなわちレテイクル14を露光装 置にセツトした際、投影レンズ系の光軸が通る部 分に主尺パターン15が設けられ、このパターン 15からy方向に例えば土40mm離れた位置に副尺 パターン 1 6 a, 1 6 b、そしてx方向に例えば が配されている。

本実施例を用いて、例えば1/10縮小投影レンズ 系の光学特性を検査するためには、第3図bに示 すように、先ず主尺パターン15の部分にレンズ 35 系の光軸が通るようにレテイクル14を露光装置 にセットし、最初に点線のようにレテイクル 14 の像をウエハ等のフオトレジストを塗布した転写 対象物(感光基板)に焼き付ける。

次に、レーザー干渉計測長器等の測定値に基づ 率誤差などが理想的に零のとき、ウエハ上に投影 40 いて、ウエハステージをy方向にー 4 麻送りレテ イクル14の像を焼き付けると、焼付像21がで き、このとき最初に焼き付けた副尺パターン18 aの像である副パーニアと 2回目に焼き付けた主 尺パターン15の像である主パーニアが重なつた

6

パーニアAが形成される。

次いで1回目の焼き付け位置からウエハステー ジを×方向にー4㎜送りレテイクル14の像を焼 き付けると、今度は焼付像22ができそれにより 1回目の焼付けによる副尺パターン 1 6'cの副パ 5 ーニアと3回目の焼付けによる主尺パターン15 の主パーニアが重なつたパーニアBが形成され

以下同様な操作で焼付像23,24を転写し、 ン16bによる副パーニアの重なつたパーニア C、および主尺パターン 15による主パーニアと 副尺パターン18dによる副パーニアの重なつた パーニアDを形成する。

で観察する。このとき、投影レンズ系の光軸の通 る主尺パターン15の像である主パーニアは焼付 **像の中心にあるため、一般に歪曲、倍率誤差など** を測る際の基準となる。そのため投影レンズ系の ずれ量を読み取るだけでx、y方向の絶対的な歪 曲などが求まる。即ち、従来例では投影像の両縁 の相互の相対的な位置しか測定できなかつたが (換言すれば歪曲があつても絶対的な量として測 うに基準となる主尺パターン15を設けたので、 各パーニアの目盛を直読するだけで光軸を基準と した投影レンズ系の絶対的な歪畳、倍率誤差等が 測定できる。尚、パーニアの目盛としての格子矯 およびその読み方について詳じくは後述する。

次に、第4図に第2実施例を示す。本実施例で は副尺パターン16a~18dがレテイクル14 の4隅に設けられていて、各副尺パターン18 a ~16dは主尺パターン15から例えば等距離に 目の焼き付け位置からウエハステージをx方向に 4 mm、 y 方向に - 4 mm送つて焼付像 2 5 、 x 方向 にー4㎜、y方向にー4㎜送つて焼付像28、x 方向に-4㎜、y方向に4㎜送つて焼付像27、 x方向に4㎜、y方向に4㎜送つて焼付飽28が 40 形成されている。そして、主尺パターン15によ る主パーニアと副尺パターン16aによる副パー ニア、副尺パターン16bによる副パーニア、副 尺パターン18cによる副パーニア、副尺パター

ン16 cによる副パーニア、副尺パターン16 d による副パーニアとでそれぞれパーニアA。B, C。Dを形成している。

第1実施例では投影像の中心から4㎜の上下左 右の位置での歪曲などを測定したが、第2実施例 では投影셵の4隅での歪曲などを測定しうる。即 ち、第1及び第2実施例によれば副尺パターンは 主尺パターンに対する配置が予めわかつている限 り、レテイクルの任意の位置に配置でき、それに 主尺パターン 15 による主パーニアと副尺パター 10 より投影像のどの位置においても絶対的な歪曲、 倍率誤差なども測定しうる。

ところで第3図、第4図で主、副尺パターンは 逆丁字形をしているが、これはx方向とy方向に 伸びる2つの格子縞パターンを互いに直交させて こうして形成されたパーニアA~Dを顕微鏡等 15 設けてあるからである。第5図にこの主尺パター ンの一例を拡大して示し、第6図にこの副尺パタ ージの一例を拡大して示す。

第5図において、格子縞パターン120aはレ テイクル14上にx方向に一定ピツチで設けら 光軸を基準として、各パーニアA~Dの格子縞の 20 れ、格子縞パターン120bはパターン120a と同様にy方向に沿つて設けられる。各格子縞パ ターン120a,120bには、パターンの中央 を0とし正と負の方向に2,4,8,8と目安と なる数字が打たれている。格子縞パターン50 定できなかつた)、本実施例では、光軸を通るよ 25 a, 50bは格子線パターン120a, 120b の補助として設けられたもので、荒いパーニアと して働く。

第8図の副尺パターンにおいて、これは主尺パ ターンの格子繞パターン120a,120bのピ 30 ツチよりもわずかに大きい (または小さい) ピツ チで設けられた格子繞パターン130a,130 bを有し、パターン130a,130bの各格子 はそれぞれ格子繞パターン l 2 0 a。 1 2 0 bの 格子間にはさまるように形状決めされている。荒 ある。1回目の焼付像が点線で示され、以下1回 35 いパーニアとして働く格子編パターン51a,5 1 b についても同様に、主尺パターンの格子線パ ターン50a,50bのピツチよりもわずかに大 きい (または小さい) ピツチで設けられ、パター ン51a,51bの各格子はそれぞれパターン5 O a, 5 O b の格子間にはさまるように形状決め されている。

主パーニアと副パーニアを重ねて焼き付けたと き、格子縞パターン120aの0の所に対応する 主パーニアの部分にパターン 130 aの中央部の 7

格子xoに対応する主バーニアの格子像がはさま れ、格子縞パターン120bの0の所に対応する 主パーニアの部分にパターン1306の中央部の 格子y。に対応する副パーニアの格子像がはさまれ ると、このとき焼付像はその重ね合わせた位置に 5 おいてx、y方向との歪曲、倍率誤差が零とな る。

第7図は第5図と第6図の格子縞パターン12 Oa, 130aの格子の一例の更に詳しい拡大図 を、第7図bはパターン130aの方の格子を示 す。

第7図aに示す如く、主尺パターン側の格子稿 パターン 1 2 0 a の各格子には段階部 1 0 0 とテ れ、格子間のピッチPnは例えば10.0umに定めら れている。また第7図bに示す如く、副尺パター ンの方の各格子は幅を主尺パターンの格子間間隔 dと等しくし、ピツチPaを例えば10.1μmとして パ部は、パーニアを読み取り易くするためのもの で、従つて主尺パターン、副尺パターンのいずれ かの側の格子に設ければよい。

第8図は、第7図a, bの格子縞パターンを1/ 10に縮小して重ね焼きしたときの様子を示し、副 25 パーニアの成る格子Siが主パーニアの格子間に完 全に挟み込まれている。この判定は格子Siに接す る上下の階段部とテーパ部を見ることにより容易 に行われる。この格子Siに着目すれば、格子Si、 E1, E2, E1において、ずれが例えばそれぞれ O、 +0.1μm、+0.2μmと判定でき、0.1μm以上の精度 で重なり重合(ずれ量)を測定できる。

実際には第5図、第6図の主、副パーニアを重 ね焼きしたとき、格子縞パターン120a, 12 35 C bの像の中のどこが位置E になつているかを 数字でもとめる。例えば、格子縞パターン120 aの正側の6の像のところで格子縞パターン13 . 0 aの 1 つの格子像が安全にはさみ込まれている とするなら、x方向の歪み量は+0.6μmと求ま 40

8

る。このとき同時に格子縞パターン120bの負 側の2の像のところで格子縞パターン130bの 1つの格子像が完全にはさみ込まれているなら、 y方向の歪み量は-0.2μmと求まる。

以上により、ウエハ上の主と副パーニアを重ね 合わせた位置における投影レンズの歪み量はx方 向で+0.6μm、y方向で-0.2μmの成分をもつべ クトル量として測定される。

ところで以上において主バーニアと副バーニア であり、第7図aはパターン120aの方の格子 10 等における主と副の用い方は全く相対的なもの で、いずれを主あるいは副と名付けてもよい。

また、上記実施例ではパーニアを用いてずれ量 を測定したが、パーニアではなく、例えば長さ等 が異なる 2種類の矩形パターン等を用意してお ーパ部101が中心軸 1 に対して対称に設けら 15 き、その一方の種類の矩形パターンをレテイクル の中心に、他の種類の矩形パターンをレテイクル 上の測定したい位置とに配置してこれらをウェハ 上に重ね焼き付けしてずれ量を測定してもよい。

以上の如く本発明によれば、マスク基板上の複 いる。主尺パターンのこれら格子の段階部とテー 20 数のマークのうち1つの投影光学系の光軸が通る 位置に設けたので、焼付像の任意の位置の絶対的 なずれ量が測定できて投影光学系の光学特性を正 確に測りうる。

## 図面の簡単な説明

第1図は従来例を説明するための図、第2図は 焼付像のずれから投影光学系の光学特性を測定す ることを説明するための図、第3図は本発明の第 1実施例を説明するための図、第4図は第2実施 例を説明するための図、第5図は主尺パターンの 1つ上方の格子S₂、2つ上方の格子S₄の各位置 30 一例を示す拡大図、第6図は副尺パターンの一例 を示す拡大図、第7図は主尺および副尺パターン の各格子の形状の一例を示す拡大図、第8図は第 7 図に示す格子を重ね焼き付けしたときの様子を 示す図である。

> 〔主要部分の符号の説明〕、マスク基板……1  $4, \forall -2 \dots 15, 16a \sim 16d, 50a$ 50b, 51a, 51b, 120a, 120b, 130a, 130b、段階部……100、テーパ 部……101。

